

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 平野博茂 副委員長 大見俊一郎

幹事 森 貴洋・小林伸彰 幹事補佐 野田泰史・諏訪智之

日時 1月31日(月) 13:15~17:00

会場 オンライン開催

議題 先端 CMOS デバイス・プロセス技術 (IEDM 特集)

1. [招待講演] 16 nm Fin FET プロセス混載 STT-MRAM における 72% の書込みエネルギー低減を達成したセルフターミネーション書込み方式 齊藤朋也 (ルネサス)
2. [招待講演] 大容量 STT-MRAM 向け一桁ナノメートル磁気トンネル接合技術 陣内佛霖 (東北大)
3. [招待講演] 高速荷電中心解析によるチャージトラップのダイナミクス把握に基づく HfO<sub>2</sub>-FeFET サイクル劣化メカニズム解明 市原玲華 (キオクシア)
4. [招待講演] 表面ラフネス散乱の新モデルに基づく極薄膜 nMOSFET の最適なチャネル材料と面方位の設計 隅田 圭 (東大)
5. [招待講演] CAAC-IGZO FET/Si CMOS 微小電流メモリセルによる高演算効率アナログインメモリコンピューティング 黒川義元 (半導体エネルギー研)
6. [招待講演] 3D シーケンシャル技術を用いた CMOS イメージセンサー 山元純平 (ソニーセミコンダクターソリューションズ)
7. [招待講演] IEDM2021 を振り返って 黒田理人 (東北大)

◆応用物理学会共催

【問合先】

SDM 幹事: 森 貴洋 (産総研)

TEL (029) 849-1149

E-Mail mori-takahiro@aist.go.jp